**IR2110, IR2113**

**Драйвер ключей нижнего и верхнего уровней**

Отличительные особенности:

* Управляющие каналы разработаны для нагруженного функционирования полностью работоспособны до +500В или +600В
* Нечувствителен к отрицательным напряжениям при переходных процессах
* Стойкость к скорости нарастания напряжения (dV/dt)
* Диапазон напряжения питания драйверов 10…20В
* Блокировка при снижении напряжения
* Отдельное питание логики от 5В до 20В
* Смещение логики и общего питания ±5В
* Входы с КМОП триггерами Шмита с привязочными резисторами к общему питания
* Тактирование логики выключения
* Согласованная задержка распространения для обоих каналов
* Выходы драйвера в фазе со входами
* Напряжение смещения VOFFSET
    не более 500В (IR2110)
    не более 600В (IR2113)
* Имп.вых. ток к.з Iо± 2 А/ 2 А
* Выходное напряжение драйверов VOUT 10 – 20В
* Время вкл./выкл. 120/94 нс
* Согласованная задержка 10 нс

Типовая схема включения:



Блок-схема:



Расположение выводов:



Описание выводов:

|  |  |
| --- | --- |
| Vdd | Питание логики |
| HIN | Логический вход управления выходом драйвера верхнего уровня (HO), в фазе |
| LIN | Логический вход управления выходом драйвера нижнего уровня (LO), в фазе |
| SD | Вход выключения |
| VSS | Логический общий |
| VB | Напряжение питания ключей верхнего уровня |
| HO | Выход драйвера верхнего уровня |
| VS | Возврат питания верхнего уровня |
| VCC | Питание драйверов нижнего уровня |
| LO | Выход драйвера нижнего уровня |
| COM | Возврат питания нижнего уровня |

Описание:

IR2110, IR2113 - драйверы высоковольтных, высокоскоростных МОП-транзисторов или IGBT-транзисторов с независимыми выходными каналами нижнего и верхнего уровней. Собственная HVIC-технология и стойкая к защелкиванию КМОП-технология позволили создать монолитную конструкцию.

Логический вход совместим с стандартными КМОП или LSTTL выходом. Выходы драйверов отличаются высоким импульсным током буферного каскада, что выполнено для минимизации встречной проводимости драйвера. Задержка при распространении сигналов согласована для применения в высокочастотных приложениях. Выходной канал может быть использован для управления N-канальным силовым МОП-транзистором или IGBT-транзистором с напряжением питания верхнего уровня до 500В или до 600В.